

(19)
(12)

(KR)
(B1)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
H05B 33/10

(45)
(11)
(24)

2002 10 30
10 - 0358503
2002 10 14

(21)
(22)

10 - 2000 - 0070712
2000 11 25

(65)
(43)

2002 - 0040998
2002 05 31

(73)

1355 - 26

1 951 - 20 26/3

3 - 101

(72)

219 - 27

1 951 - 20 26/3

3 - 101

(74)

:

(54)

(Full Color)

EL

1 (3), 2 (4), 3 (5) (1) (2) ; (2)

2 (4) (6a) (6) (8a) (7b), (8b) (9) (3) (5) (6a) (7a) (9)

, , , , ,

1 EL ,

2 10 .

<

1 : 2 : (ITO) ,

3 : 1 , 4 : 2 ,

5 : 3 , 7 : ,

8 : 9 :

22 : (Red) , 23 : (Green) ,

24 : (Blue) .

(Electro - Luminesecence, "EL") EL
(Full Color)
EL .

EL PDA , ,
가 .

1 (Passive Matrix) 가 EL .
EL , 1 (10)
ITO(Indium Tin Oxide) () (20) . (20) / /
(30) (30) () (40)
EL SUS () ,
가 가 .

EL ITO (20) "+"
가 , (40) "- " 가 , ITO (20) , (40) 가
(30) . ITO (20)
(10) .

EL (Organic Material)
R.G.B. 가 가

가 1 가

(1) (2) ; (2)
1 (3), 2 (4), 3 (5) ; 1 (3)
(4) 2 (4) (6a) (5)
2 (4) (6a) (6) ; 2 (4) (6a) (7
a) ; (7a) (8a) ; (8a) (9)
; 3 (5) (7b), (8b) (9)

1 (3), 2 (4) 3 (5) SiO₂, SiNx

3 (5) 1 (3) 2 (4)

CMP (Chemical Mechanical Polishing)

(Dry Etching)

가

(22) (22) (23) (22) ;
(23) (24) ;

(1); (1) (2);
(2) 1 (3); 1 (3) ;
(6a) (6a) 2 (4); 2 (4) (4) (
(6) 3 (5); 1 (3) 2 (4) (
6a) 2 (4) (7a); (7a)
(8a); (8a) 3 (5)
(9);

(22);
(22) (23);
(23) (24);

2 10
2 10

2 (1)

3 (1) ITO () (2)

4 (2) 1 (3), 2 (4) 3 (5)

SiO₂, SiNx 1
(3), 2 (4) 3 (5) (2)
(Strip) (3) 2 (4) (2) , 3 (5) 1
(3) 2 (4)

5 (3) 1 (3) 2 (4)
(6a) 3 (5) (6a) (6)

6 (Blue) (7a) (7a) 2 (4)
(6a) (7a) 1 (3)
2 (4) 3 (5) 3 (5)
(7b)

7 (7a) (7b) (8a, 8b)
(7b) (8b) (8a, 8b)

8 (8a, 8b) (9) (9)
3 (5) (6) (9)

9 (9) 3 (5)
CMP (Chemical Mechanical Polishing) (Dry Etching)
가 가 ()

10 (3, 4, 5)
(1 1) R.G.B.
10 (Red) (22), (G
reen) (23), (Blue) (24)가

가

EL

가

가

(Anode)

(Cathode)

가

가

가

(57)

1.

(1)

(2)

;

(2)

1

(3),

2

(4),

3

(5)

;

1

(3)

,

2

(4)

(6a)

,

3

(5)

2

(4)

(6a)

(6)

;

2

(4)

(6a)

(7a)

;

(7a)

(8a)

;

(8a)

(9)

;

3

(5)

(7b),

(8b)

(9)

2.

1

,

1

(3),

2

(4)

3

(5)

SiO₂, SiNx

3.

1

,

3

(5)

1

(3)

2

(4)

4.

1

,

CMP(Chemical Mechanical Polishing)

5.

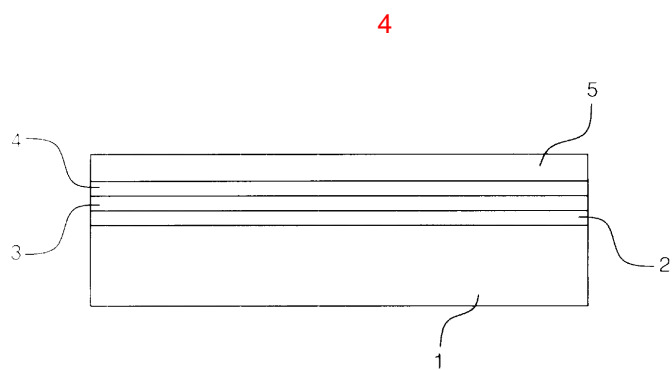
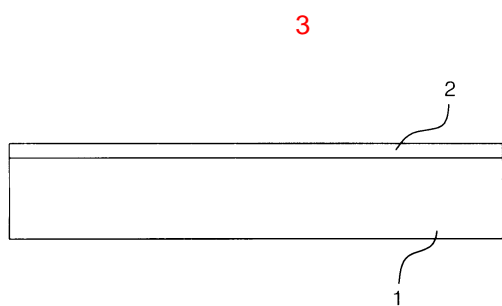
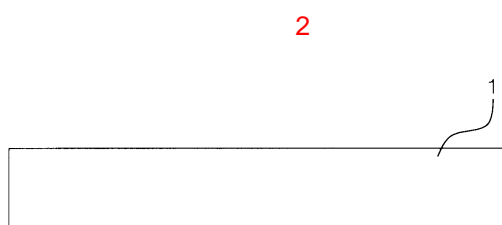
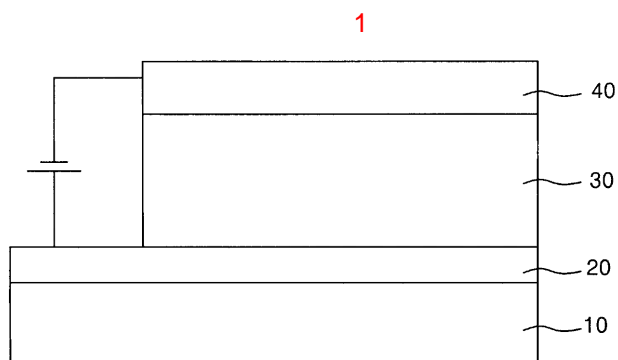
1 3 (22) ;
 1 3 (22) (23) ;
 1 3 (23) (24) ;
 .

6.

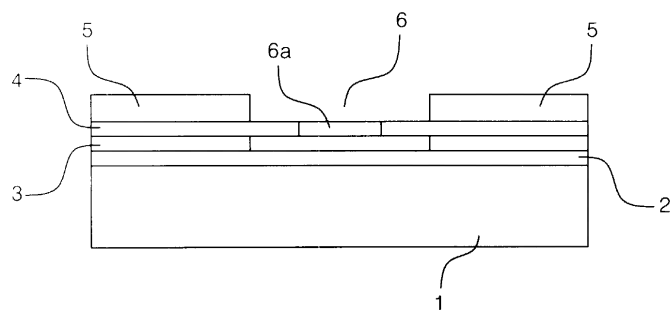
(1);
 (1) (2);
 (2) , 1 (3);
 1 (3) , (6a) 2 (4);
 2 (4) , 2 (4) (6a) (6) 3 (5);
 1 (3) 2 (4) (6a) , 2 (4)
 (7a);
 (7a) (8a);
 (8a) , 3 (5) (9);
 .

7.

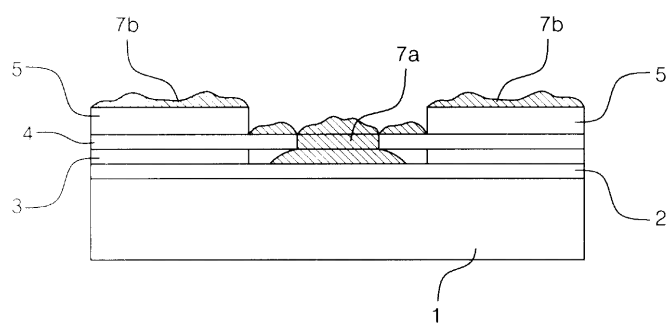
6 (22);
 6 , (22) (23);
 6 , (23) (24);
 .



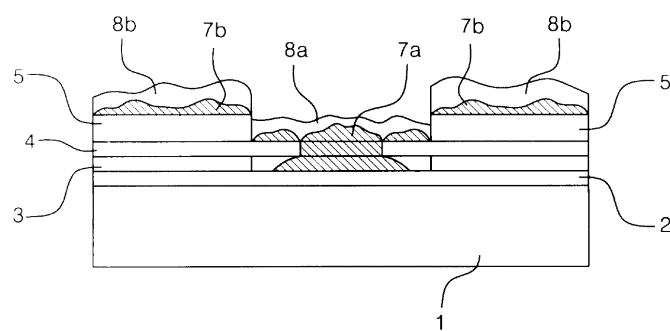
5



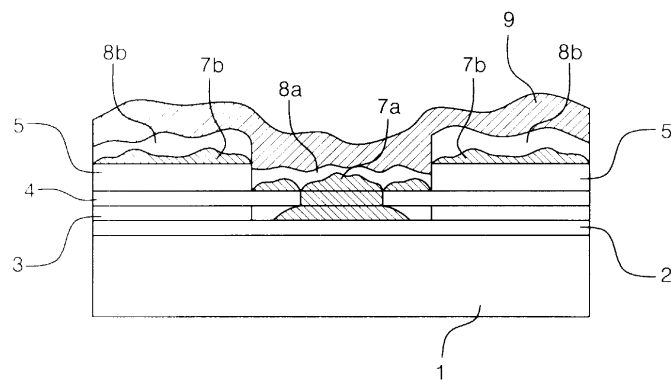
6



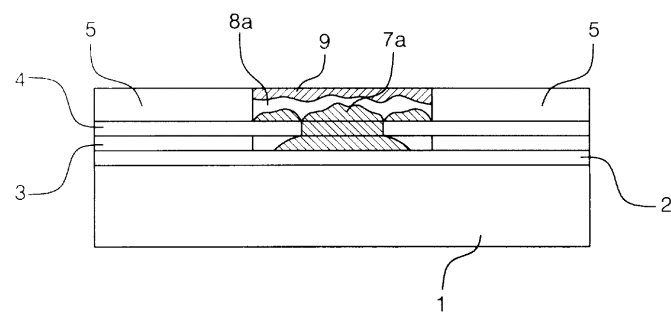
7



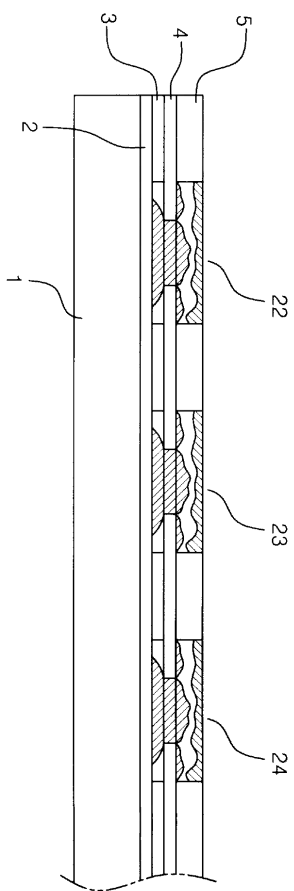
8



9



10



专利名称(译)	有机电致发光显示面板及其制造方法		
公开(公告)号	KR100358503B1	公开(公告)日	2002-10-30
申请号	KR1020000070712	申请日	2000-11-25
[标]申请(专利权)人(译)	ELIATECH 公园胜利 Bakwonseok		
申请(专利权)人(译)	电梯技术有限公司. Bakwonseok		
当前申请(专利权)人(译)	电梯技术有限公司. Bakwonseok		
[标]发明人	KANG SINKYU 강신규 PARK WON SEOCK 박원석		
发明人	강신규 박원석		
IPC分类号	H05B33/10		
代理人(译)	孙某EUN JIN		
其他公开文献	KR1020020040998A		

摘要(译)

本发明涉及一种用于提高全色精细图案的对准精度的有机EL显示板及其制造方法。为此目的，提供一种制造薄膜晶体管的方法，包括：在透明基板（1）上沿一个方向沉积阳极层（2）；在阳极层（2）的上表面上依次形成第一绝缘层（3），第二绝缘层（4）和第三绝缘层（5）；第一在第二绝缘层4中形成宽度窄于凹槽的凹槽6a，并且在绝缘层3中形成宽度小于凹槽宽度的凹槽6a，形成宽度大于绝缘层（4）的凹槽（6a）的凹槽（6）；在第二绝缘层（4）的槽（6a）内形成发光层（7a）；阴极层8a形成在发光层7a的上表面上步骤；在阴极层（8a）的上表面上形成保护层（9）；去除位于第三绝缘层（5）的上表面上的发光材料残留物（7b），阴极材料残留物（8b）和保护层（9）以平坦化有机发光显示面板提供了一种方法及其面板。9 指数方面 - 1 - 有机，电致发光，面板，沉积，绝缘体，金属

